

Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Саранск (8342)22-96-24

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

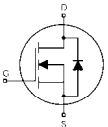
Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://sirectifier.nt-rt.ru/> || sfx@nt-rt.ru

碳化硅MOSFET分立器件

SiC MOSFET Discretes

型号 TYPE	电气特性Electrical Characteristics						封装外形 Package Style	沟道极性 Configu- rations	外形图 Outlines			
	V _{DSS}	I _{D25}	R _{DS(ON)}	I _{DSS}	V _{GSTH}	T _{JMAX}						
		T _C =25 ℃										
	V	A	mΩ	uA	V	℃						
650V Series SiC MOSFET Discretes									TO-247AD   N Channel			
SCM11665R17B2	650	116	17.00	5.00	2.60	150	TO-247AD	N CH				
SCM7865R30B2	650	78	30.00	3.00	2.60	150	TO-247AD	N CH				
SCM3865R60B2	650	38	60.00	2.00	2.60	150	TO-247AD	N CH				
SCM2065R120B2	650	20	120.00	1.00	2.60	150	TO-247AD	N CH				
1200V Series SiC MOSFET Discretes												
SCM80120R25B2	1200	80	25	5.00	2.60	150	TO-247AD	N CH				
SCM60120R40B2	1200	60	40	5.00	2.60	150	TO-247AD	N CH				
SCM30120R80B2	1200	30	80	2.00	2.60	150	TO-247AD	N CH				
SCM18120R160B2	1200	18	160	1.00	2.60	150	TO-247AD	N CH				
SCM09120R280B2	1200	9	280	1.00	2.60	150	TO-247AD	N CH				